

厚膜SOIウェーハ II

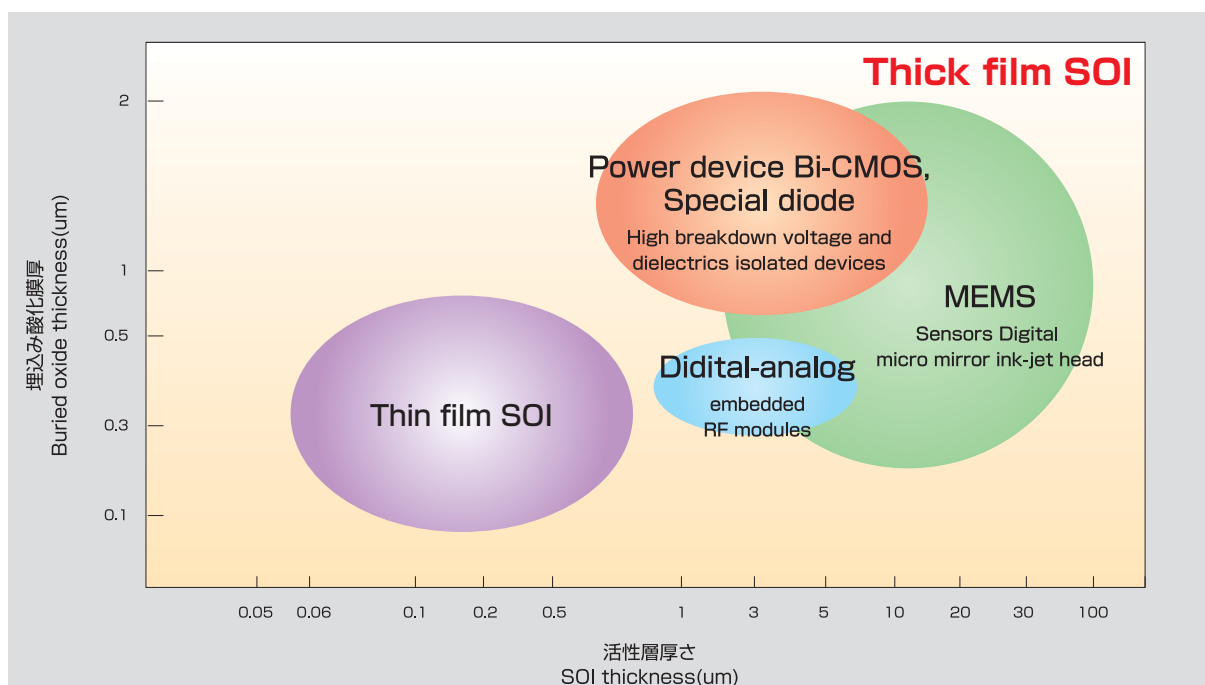
Thick Film SOI Wafer

カスタマイズ仕様 Customized specification

特長 Features	仕様 Capability	メリット Benefit
テラスフリー Terrace-free	直径100~150mm(4~6インチ) Dia100~150mm(Dia4~6inch)	チップ収量増(~7%) Chip-area increase
薄基板 Thin-handle wf	最小200 μ m厚さ(4インチ) 最小300 μ m厚さ(6インチ) min200um(4inch) min300um(6inch)	深掘り加工に対応 Deep-et'g for MEMS
裏面鏡面 Back-side polish	直径100~150mm(4~6インチ) Dia4~6inch	裏面へのホトリソグラフ対応 Back-side PEP for MEMS
その他 Others*	Buried oxide layer(3 μ m以上) Buried oxide layer(over 3um) 面方位(110) Orientation(110)	高耐圧素子分離、エッチストッパー機能 High-BV, etch-stopper 高エッチレートかつ垂直溝掘り対応 High-etchrate(110>100)

※その他のご要望につきましては、別途ご相談に応じます。
For further requirements need to be discussed.

SOIウェーハの応用 Thick film SOI Wafer



COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

シリコン事業本部

東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8416 Fax:03-5437-7433 E-mail:sil_j331@covalent.co.jp

www.covalent.co.jp